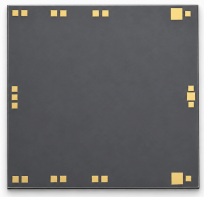
11500–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 44 dBm (最小值) / 44.5 dBm (典型值); 功率增益: 19 dB (最小值) / 19.5 dB (典型值); PAE: 28 % (最小值) / 30 % (典型值). 裸片尺寸: 3.52 × 3.55 × 0.1 mm.



RF 特性 · TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
工作频率	f	11500	-	18000	11500–18000	MHz
饱和输出功率	Psat	44	44.5	-	-	dBm
功率增益	Gp	19	19.5	-	-	dB
功率增益平坦度	ΔGp	-	-	±0.5	-	dB
功率附加效率	PAE	28	30	-	-	%
小信号增益	S21	28	29	31	-	dB
小信号增益平坦度	ΔS21	-	-	±1.5	-	dB
输入驻波比	VSWR(in)	-	1.8	2	-	-

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏极电压	Vd	-	28	-	-	V
栅极电压	Vg	-	-2.4	-	-	V
静态漏极电流	Id	-	-	-	1.85 (Vd = +28 V; 可按实际需要调节；资料未将该数值标注为最小值、典型值或最大值。)	A

极限参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	Vd	-	-	32	V
栅极最低偏置电压	Vg	-5	-	-	V

极限参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最大输入功率	Pin	-	-	28	dBm
储存温度	TSTG	-65	-	150	℃
最高沟道温度	Top	-	-	200	℃

裸片尺寸

参数	数值	单位
裸片尺寸	3.52 × 3.55 × 0.1	mm

当前出版记录 · 1.4 · 2026-10-26. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.3.

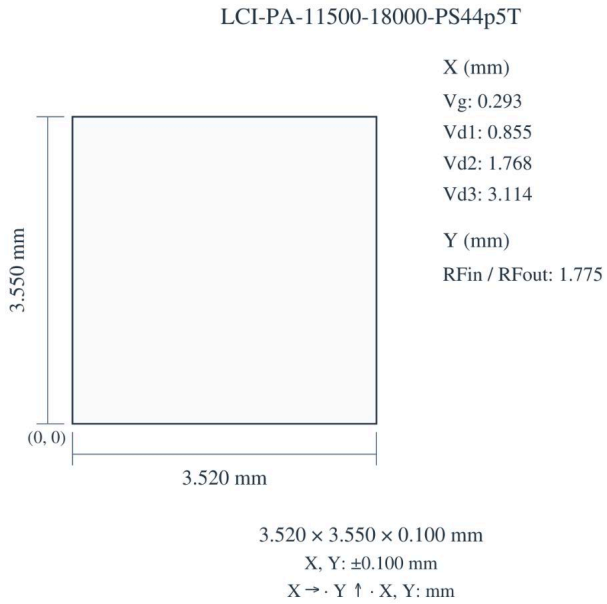
裸片集成与偏置时序

内置隔直电容: RFin / RFout. 直流对地通路: RFin / RFout → GND. 内部连通的栅极焊盘: Vg ↔ Vg. 独立表征条件: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 µs; D = 10%. 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。

机械参考图适用范围

依据原资料整理的外形及明确标注坐标参考图，单位 mm；不作为完整制造或键合图。

机械外形尺寸图



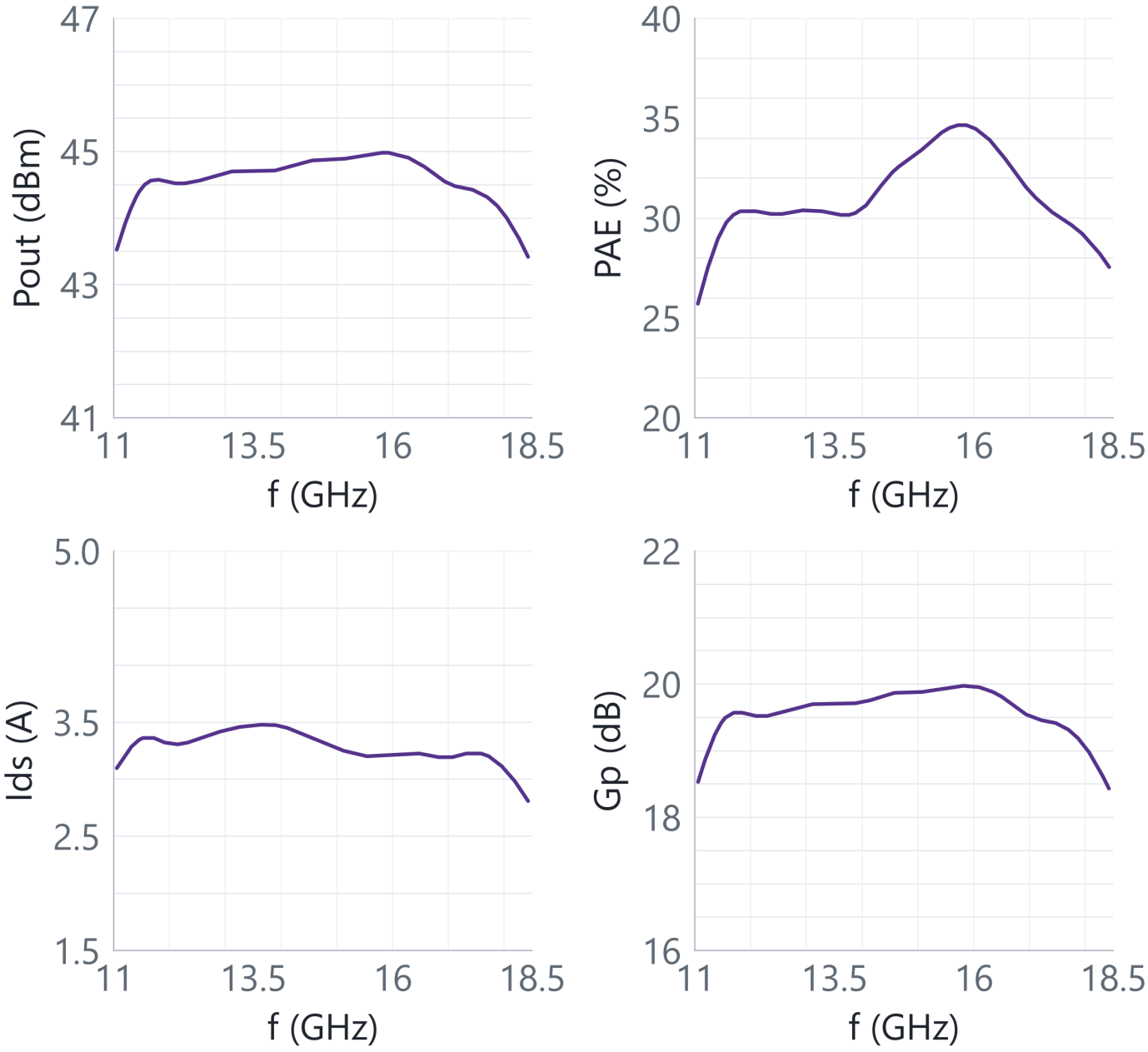
所有尺寸单位为 mm [in]。

性能曲线

以下图表来自原规格书，请结合每张图标明的工作条件阅读。

脉冲模式 — 饱和输出功率、动态漏极电流、功率附加效率、功率增益。

原页标注：TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.4V; Pin=25dBm。 脉冲宽度 = 100 µs；占空比 = 10%。 根据原图数字化重绘，读数为近似值。



来源

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。